

Au/Ga₂O₃/ZnO heterostructure nanorods arrays for effective photoelectrochemical water splitting

Abdalla, Akram; Khan, Ibrahim; Sohail, Manzar; Qurash, Ansanulhaq Solar energy 2019 / p. 333-338 : ill

<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.01.065> [Journal metrics at Scopus](#) [Article at Scopus](#) [Journal metrics at WOS](#) [Article at WOS](#)

Characterization of silicon carbide (SiC) and graphene-based novel semiconductor devices = Ränikarbiidil (SiC) ja grafeenil põhinevate uudsete pooljuhtstruktuuride karakteriseerimine

Rashid, Muhammad Haroon 2021 https://www.ester.ee/record=b5397240*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/a64fd50e-125c-49ad-b0a6-6ad2e01b8bfa> <https://doi.org/10.23658/taltech.6/2021>

Charge selective contact on ultra-thin In(OH)_xSy/Pb(OH)_xSy heterostructure prepared by SILAR

Gavrilov, S.; Oja Acik, Ilona; Lim, B. Physica status solidi (a) 2006 / 5, p. 1024-1029 : ill

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pssa.200521468>

Comparison of methods for solving the Schrödinger equation for multiquantum well heterostructure applications

Udal, Andres; Reeder, Reeno; Velmre, Enn; Harrison, Paul Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2006 / 3-2, p. 246-261 : ill

Comparison of the dynamic behaviour of complementary 6H- and 4H-SiC Schottky structures using numerical simulation

Rang, Toomas; Kurel, Raido Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2004 / 3, p. 173-178

Development and optimisation of modelling methods and algorithms for terahertz range radiation sources based on quantum well heterostructures = Kvantaukudega heterostruktuuridel põhinevate terahertsikiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine

Reeder, Reeno 2014 https://www.ester.ee/record=b3084247*est

Effects of the inclusion of armchair graphene nanoribbons on the electrical conduction properties of NN-heterojunction 4H-6H/SiC diodes

Rashid, Muhammad Haroon; Koel, Ants; Rang, Toomas Advanced Materials and Processing Technologies : 2nd International Conference on Sensors, Materials and Manufacturing (ICSMM 2018, November 19-21, 2018, Taiwan); International Conference on Materials Sciences and Nanomaterials (ICMSN 2018, July 11-13, 2018, United Kingdom) and the 2nd International Conference on Materials and Intelligent Manufacturing (ICMIM 2018, August 24-26, 2018, Japan) 2019 / p. 29-35 : ill

<https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.962.29> [Conference proceeding at Scopus](#) [Article at Scopus](#)

Elektrokeemilised CuInS₂/polüürrool fotovolt struktuurid

Bereznev, Sergei; Konovalov, Igor; Kois, Julia; Mellikov, Enn; Öpik, Andres XXVIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 28th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference 2002 / lk. 19

In situ Al₃BC/Al composite fabricated via solid-solid reaction: An investigation on microstructure and mechanical behavior

Maity, Tapabrata; Prakash, Aditya; Roy, Debdas; Prashanth, Konda Gokuldoss Applied sciences 2025 / art. 5189

<https://doi.org/10.3390/app15095189>

Numerical analysis of forward-biased diode structures based on direct-gap semiconductors

Velmre, Enn; Freidin, Boris Electronics letters : an international publication 1979 / p. 383-385

https://www.ester.ee/record=b2180432*est

Numerical analysis of the influence of deep energy level traps in SiC Schottky structures

Koel, Ants; Rang, Toomas; Rang, Galina High performance structure and materials. VI 2012 / p. 439-448 : ill

Numerical analysis of the on state of diode structures based on direct-gap semiconductors

Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres Physica scripta : an international journal for experimental and theoretical physics 1981 / p. 468-471 https://www.ester.ee/record=b2244094*est

Numerical modeling of the electrothermal transient process in diode structures based on direct-gap semiconductors

Velmre, Enn; Freidin, Boris Physica status solidi. A, Applied research 1983 / p. K131-K134 https://www.ester.ee/record=b1562026*est

Numerical simulation of a forward-based p-i-n structure with band-to-band Auger recombination

Freidin, Boris; Velmre, Enn Electronics letters : an international publication 1978 / p. 701-703

https://www.ester.ee/record=b2180432*est

Pooljuhtstruktuuride tööpõhimõtted. Struktuuride realiseerimised kristallis : abimaterjal ainele "Mikroelektroonika"

2003 http://www.ester.ee/record=b1782563*est

Principles of semiconductor structures. Realisation of structures in crystals : supplementary lecture material in the subject "Microelectronics"

Rang, Toomas 2003 http://www.ester.ee/record=b1782565*est

Simulations of heterostructures based on 3C-4H and 6H-4H silicon carbide polytypes

Rashid, Muhammad Haroon; Koel, Ants; Rang, Toomas Silicon carbide and related materials 2017 : ICSCRM 2017 : selected, peer reviewed papers from the 2017 International Conference on Silicon Carbide and related materials, September 17-22, 2017, Washington, DC, USA 2018 / p. 302-305 : ill <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.924.302> [Conference Proceedings at Scopus Article at Scopus](#)

Влияние распределения примеси на прямую ВАХ арсенидгаллиевых силовых диодных структур

Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 32-37
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Изучение ошибок модели управления технологического процесса создания силовых полупроводниковых структур

Saks, Eva Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 71-72
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Исследование эффективности численных алгоритмов моделирования проводящего состояния силовых полупроводниковых структур

Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 34-35
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Исследование эффективности численных алгоритмов моделирования силовых полупроводниковых структур в проводящем состоянии

Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический журнал 1981 / с. 85-88 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

К расчету некоторых параметров процесса лавинного размножения носителей в резких кремниевых р-п-переходах

Vaher, G.; Velmre, Enn Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 89-96
https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Компенсационное управление операций I- облучения

Bachverk, Aleksander; Saks, Eva Автоматизация технологических процессов на базе применения управляющей вычислительной техники : [тезисы докладов научно-технического семинара 1984 / с. 49-52
https://www.ester.ee/record=b1289375*est

Методы исследования исходных полупроводниковых материалов и эпитаксиальных структур

Mere, Arvo; Paat, Aadu; Rusalep, Ervin; Uder, Ülo-Olimar Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 2 1978 / с. 173-180
https://www.ester.ee/record=b1273255*est

Определение характеристик силовых диодных структур методом фотохронографии рекомбинационного излучения

Kruusing, Arvi; Udal, Andres; Vaher, G. Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 129-133 https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Поверхностная фото-ЭДС в полупроводниках и в полупроводниковых структурах : автореферат ... кандидата физико-математических наук (01.04.07)

Seilenthal, Mats 1982 https://www.ester.ee/record=b1279678*est

Повышение эффективности численных алгоритмов моделирования силовых полупроводниковых структур в проводящем состоянии

Rubinstein, M.; Freidin, Boris XXV студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1981 / с. 18-19 https://www.ester.ee/record=b1322629*est

Применение анодного окисления при исследовании электрофизических характеристик полупроводниковых структур "кремний на изоляторе"

Gavrilov, Aleksei Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 53-59: ill

Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ

1982 https://www.ester.ee/record=b1339926*est <https://www.etera.ee/zoom/121726/view?page=3&p=separate&search=true&tool=search>

Проблемы оптимизации аксиального профиля времени жизни носителей заряда в структуре

быстродействующего тиристора

Surma, A.; **Udal, Andres**; Assina, Svetlana Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 18-21 : ил https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Программа "Динамит-1" для одномерного численного моделирования тиристорных структур

Velmre, Enn; **Udal, Andres** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 59-63 : ил https://www.ester.ee/record=b1591355*est

Расчет коэффициентов лавинного размножения в резких кремниевых р-п переходах

Vaher, G.; **Velmre, Enn** Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 49 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Сравнение статических параметров диодных структур из GaAs и InP

Velmre, Enn; **Nurste, Ivar**; **Freidin, Boris** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 30-31 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Физические аспекты учета влияния эффекта электронно-дырочного рассеяния при математическом моделировании полупроводниковых структур

Velmre, Enn Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 / с. 166-174

Численное моделирование напряженности электрического поля и напряжения пробоя в полупроводниковой структуре с двойной фаской

Velmre, Enn; Kuusik, E.; **Tergem, Ilmar** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 50-58 https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах

Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1984 / с. 86-88 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование процесса выключения одномерных кремниевых тиристорных структур

Velmre, Enn; **Udal, Andres** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 74-79 https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование процессов в полупроводниковых структурах с учетом рекомбинации через многозарядные центры

Velmre, Enn; Opštški, A.; **Udal, Andres** Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том 1 1987 / с. 131-134 https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Численное моделирование процессов включения и выключения диодной структуры на основе прямозонного полупроводника

Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей 1984 / с. 90-94 https://www.ester.ee/record=b1238033*est

Численное моделирование физических процессов в одномерных кремниевых диодных структурах в стационарном режиме

Velmre, Enn; **Freidin, Boris**; **Udal, Andres** Алгоритмы и программы : информационный бюллетень 1980 / с.?

Численное моделирование физических процессов в прямосмещенных структурах на основе прямозонных полупроводников

Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 25-31 https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование электротепловых процессов в силовых полупроводниковых приборах с учетом электронно-дырочного рассеяния

Velmre, Enn; **Nurste, Ivar**; **Seleninov, Kazimir**; **Freidin, Boris** Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 185-188 https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Численный анализ неизотермических переходных процессов в арсенидгаллиевых диодных структурах

Aškinazi, German; **Velmre, Enn**; Kivi, U.; Timofejev, V.; **Freidin, Boris**; Šumilin, V. Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 15 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Численный анализ одномерных полупроводниковых структур в стационарном режиме

Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной дню радио и деятельности Эстонской организации НТОРЭС им. А. С. Попова за годы 1958-1978 1978 / с.? https://www.ester.ee/record=b1314631*est

Численный анализ переходных процессов в диодных структурах на основе прямозонных полупроводников
Velvre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 26 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Экспериментальное исследование тиристорной структуры

Bachverk, Aleksander Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 73-74 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Эффективный алгоритм для одномерного численного моделирования полупроводниковых структур

Udal, Andres Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том 1 1987 / с. 146-149 https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Эффективный численный алгоритм моделирования одномерных полупроводниковых структур

Freidin, Boris Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ 1982 / с. 39-48
https://www.ester.ee/record=b1339926*est <https://www.etera.ee/zoom/121726/view?page=3&p=separate&search=true&tool=search>